## Circuitul basculant monostabil, CBM

### 1. Introducere teoretică

#### CBM cu tranzistoare

Un circuit basculant monostabil in cea mai simpla varianta are schema din figura 3.1. R<sub>B</sub> din schema CBB este inlocuita cu un grup R<sub>1</sub>, C<sub>1</sub>. Circuitul are in mod obisnuit o intrare de comandă, în figura este pe baza tranzistorului 1 dar poate fi pusă atât pe baza tranzistorului 2 cât și pe colectoare. Poate exista deasemenea si o a doua intrare de comandă, sensibila la impulsuri de polaritate opusa.

Fara o interventie exterioara, CBM, se afla intr-o stare stabila,  $T_1$  blocat si  $T_2$  in conductie.  $T_2$  este în conducție prin efectul rezistenței  $R_1$  ce polarizează baza direct de la sursa de tensiune continuă,  $E_{CC}$ .

### Mecanismul de basculare

Daca pentru starea stabilă inlocuim tranzistoarele cu schemele echivalente simplificate circuitul este cel din figura 3.2. Curentul prin  $T_1$  si  $R_C$  este zero. Ieșirea 1, căreia îi corespunde tensiunea  $U_1$  este la nivel ridicat, iesirea 2 la nivel coborat. Condensatorul  $C_1$  este incarcat cu o tensiune egala cu  $E_{CC}$ , cu semnul din figura.

Daca se comanda CBM cu un impuls pozitiv pe baza T<sub>1</sub>, pentru a-l scoate din blocare, prin mecanismul de basculare similar cu cel de la CBB se trece, intr-un interval de timp foarte mic, neglijabil, in starea a doua, T<sub>1</sub> deschis, T<sub>2</sub> blocat, iar la inceputul acestei stari schema echivalenta a CBM este aceea din figura 3.3. Deoarece timpul de basculare este foarte scurt, condensatorul ramane incarcat cu aceeasi tensiune, ca in figura. Dar in acelasi timp condensatorul incepe un proces de incarcare de la sursa prin rezistenta R<sub>1</sub>, cu un curent care tinde sa descarce condensatorul si sa-l reincarce cu semn opus. Procesul poate fi urmarit pe figura 3.4 unde sunt prezentate principalele forme de unda. Dupa basculare tensiunea de

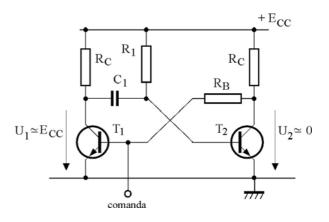


Fig. 3.1. Circuitul basculant monostabil

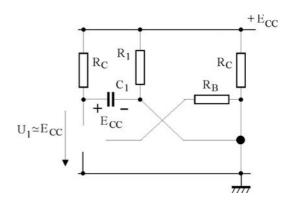


Fig. 3.2. Schema simplificata în starea stabilă.

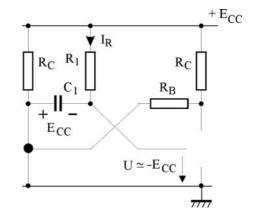


Fig. 3.3. Schema simplificata la inceputul starii cvasi-stabile

baza a T<sub>2</sub>, U<sub>B2</sub>, urmareste evolutia tensiunii pe condensator. In starea stabila, pana la

momentul  $t_1$ ,  $T_2$  era deschis si tensiunea  $U_{B2}$  era egala cu aproximativ 0,7V. La iesiri tensiunile erau la nivel coborat,  $U_2$ , ridicat,  $U_1$ .

In momentul t<sub>1</sub> se produce bascularea. La iesiri tensiunile se inverseaza. Tensiunea pe baza trazistorului T2 are un salt de la +0,7 V la o valoare negativa, egala cu tensiunea pe condensator, aproximativ -E<sub>A</sub>. Din acest moment incepe descarcarea C prin R (curentul i<sub>R</sub>) si tensiunea pe condensator ca si pe baza T<sub>2</sub> incepe sa creasca spre zero dupa o curba exponentiala tipica. Fara prezenta tranzistorului T<sub>2</sub> tensiunea pe condensator ar trece de zero si ar ajunge in final la valoarea E<sub>CC</sub> (linia punctata). Dar prezenta tranzistorului face ca o data ce tensiunea pe condensator si pe baza T<sub>2</sub> ajunge la valoarea de deschidere a T<sub>2</sub> (aproximativ 0,7 V), momentul t<sub>2</sub>, tranzistorul sa se deschida si schema sa basculeze înapoi în

starea inițială. Intr-adevar starea este cvas-stabila deoarece circuitul basculeaza singur din această stare.

Schema echvalenta in acest moment este iarasi aceea din figura 5.31. Tensiunea  $U_2$  trece brusc, prin deschiderea  $T_2$ , la valoare scazuta iar aceea din colectorul  $T_1$  la valoare ridicata. O particulariatete este ca  $U_1$  nu are o evolutie prin salt, ci ea urmareste procesul de incarcare al condensatorului, de data aceasta prin  $R_C$  si deci are o forma exponentiala, dar mult mai rapida decat in cazul incarcarii prin  $R_1$  (starea cvasistabila) fiindca  $R_C$  este mult mai mica decat  $R_1$ . Timpul in care CBM ramane in starea cvsi-stabila depinde de constanta de timp a circuitului de incarcare,  $R_1C_1$ . Acest timp este dat de formula

 $T_i = 0.7 R_1 C_1$ 

aproximativa:

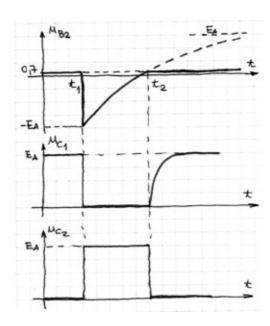


Fig. 3.4. Forma tensiunilor CBM

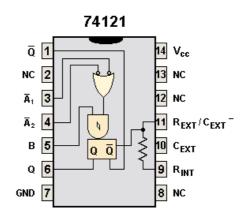


Fig. 3.5 CI 74121

#### **CBM** integrat

CBM este realizat și sub formă de circuit integrat în seria de circuite integrate din familia TTL cu variantele SN54121 sau SN74121 cu prima variantă destinată funcționării în condiții termice grele. Schema bloc și legaturile la terminale sunt prezentate în figura 3.5.

Circuitul are trei intrări de comandă, două acționând pe frontul negativ,  $\bar{A}_1$  și  $\bar{A}_2$ , iar a treia, B, pe frontul pozitiv. O schemă logică simpla la intrare permite combinații diverse de comandă. Intrarea B poate fi utilizată și pentru blocarea funcționării circuitului.

Exista două iesiri complementare, Q și  $\overline{Q}$ .

Alimentarea se face la 5 V, terminalele 7 și 14 (+). Terminalele NC sunt neconectate.

Perioada impulsului de ieșire poate fi stabilita la o valoare între 40 nS - 28 S prin alegerea a două componente exterioare, o rezistență,  $R_{EXT}$  (în gama 1,4 - 40 K $\Omega$ ) și un condensator,  $C_{EXT}$  (în gama 0 - 1000  $\mu F$ ) . Valoarea perioadei impulsului este :

$$T_i = 0.33 R_{EXT} C_{EXT}$$

#### 2. Modul de lucru

Tensiunea de alimentare va fi de 5 V.

- 1. Se va realiza montajul experimental din figura 3.6.  $R_C$ =1,8K;  $R_I$ = $R_B$ =100K;  $C_I$ =100 $\mu$ F;
- 2. Se va conecta un fir pin-pin la borna de masă. Cu vârful al doilea se va conecta pe rând masa la bazele și colectoarele tranzistoarelor, simulând astfel comenzi pe baza sau colector. Se vor face și conectări repetate la același punct.

Se va deduce modul de acțiune al comenzilor. Se va stabili legătura între starea la un moment dat a tranzistorului și basculare atât prin comandă pe bază cât si pe colector și se vor scrie observațiile în referat.

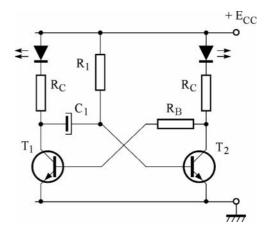
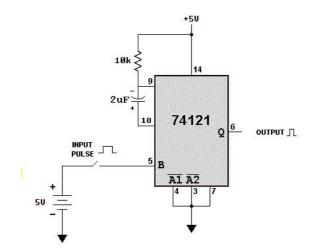


Fig. 3.6. Montaj experimental CBM

3. Se masoara timpul starii cvasi-stabile pentru doua valori ale condensatorului:  $100\mu F$  si  $10\mu F$ .si se trec datele in tabelul 1.



FUNCTION TABLE					
INPUTS			OUTPUTS		
A1	A2	В	Q.	ā	
L	×	н	L	н	
×	i.	H	Lt	ΗŤ	
×	×	L	L†	нt	
н	н	×	LŤ	НŤ	
н	Ļ	н		$\Box$	
1	н	н	1	T.	
1	1	н	17	┰	
L,	×	t	7T	T,	
_ X	L	1_		ഥ	

Fig. 3.7. Circuit utilizare 74121

- 1. Se va realiza montajul experimental din figura 3.7.
- 2. Se vor utiliza trei seturi diferite  $R_{EXT}$ ,  $C_{EXT}$  si se măsoare perioada impulsului de iesire. Se completeaza tabelul 2
- 3. Se vor face experimente activând cele trei intrări și se verifică valabilitatea tabelului de funcționare alăturat.

# Circuitul basculant monostabil

Nume	Grupa	Data

## Tabel 1

C	100 μF	10 μF
$T_{ m masurat}$		
$T_{ m calculat}$		

Calcul T

Tabel 2

$R_{ m EXT}$		
$C_{ m EXT}$		
$T_{ m masurat}$		
$T_{ m calculat}$		

Calcul T

Verificare tabel adevar:

Observatii:

# Conținutul referatului

Referatul va fi întocmit conform formularului atasat. El va conține:

- 1. Nume, prenume, data, grupa;
- 2. Tabelul 1;
- 3. Calculul T pentru tabelul 1;
- 4. Tabelul 2;
- 5. Calculul T pentru tabelul 2;
- 6. Cazurile verificate pentru tabelul de adevar al circuitului monostabil 74121;
- 7. Observatii.